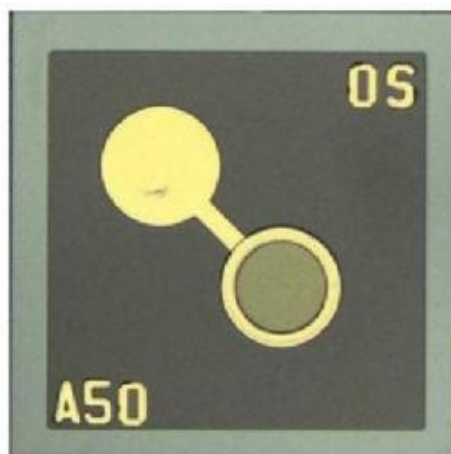


2.5Gbps InGaAs APD Chip For OLTOTDR $\phi 50\mu\text{m}$



产品描述

InGaAs 雪崩光电二极管 (APD) 芯片

产品特点

数据速率高达 2.5Gbps; $\phi 50\mu\text{m}$ 有效面积; 高响应度; 顶照式平面结构

应用领域

OTDR | GPON OLT/XG-PON OLT | 长途光纤网络

核心参数

无

无

详细参数

规格 (Tc=25°C, 单颗裸芯片)

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
响应范围	λ	900		1650	nm	
击穿电压	Vbr	40		50	V	I _d =10uA
VBR 温度系数			0.12		V/°C	
响应	R	12	15		A/W	V _R =Vbr-3V
暗电流	I _d		0.4	10	nA	V _R =Vbr-3V
电容	C		0.18	0.3	pF	V _R =38V;f=1MHz
带宽	Bw		2.5		GHz	3dB down,RL=50Ω
有效区直径	D		50		um	
芯片尺寸			250*250*150		um	L*W*H